

# Cestello Per Pulizia Wafer In Ptfе Ad Alta Purezza - Supporto Per Wafer Di Silicio Resistente Agli Acidi - Supporto Per Incisione In Fluoropolimero

Numero articolo: PL-CP284



## introduzione

Garantisci una lavorazione dei semiconduttori priva di contaminazioni con i nostri cestelli per pulizia wafer in PTFE ad alta purezza. Progettati per processi di incisione e pulizia aggressivi, questi supporti personalizzabili offrono eccezionale resistenza chimica e stabilità termica per la movimentazione di wafer di silicio durante i processi critici di produzione con prodotti chimici umidi.

## Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio chiave
<b>Pulizia standard RCA</b>	Passaggi di pulizia sequenziali SC-1 e SC-2 per rimuovere residui organici e contaminanti metallici da wafer di silicio.	Previene la lisciviazione di ioni metallici, garantendo ambienti di lavorazione ultra-puri.
<b>Incisione Piranha</b>	Utilizzo di miscele di acido solforico e perossido di idrogeno per rimuovere materiale organico pesante e fotoresist.	Resiste a reazioni esotermiche estreme e ossidazione aggressiva senza degradarsi.
<b>Immersione/Incisione con HF</b>	Rimozione di strati di ossido sacrificali o ossidi nativi utilizzando soluzioni di acido fluoridrico.	Immunità completa all'attacco dell'HF, che distruggerebbe i supporti in vetro o quarzo.
<b>Texturizzazione per celle solari</b>	Immersione di wafer di silicio in soluzioni alcaline o acide per creare texture superficiali che catturano la luce.	Produzione ad alto volume e resistenza a soluzioni concentrate di KOH o NaOH.
<b>Pulizia post-CMP</b>	Rimozione di particelle di impasto e residui chimici dopo la lucidatura meccanico-chimica (CMP).	La superficie antiaderente previene la rideposizione dell'impasto sul supporto e sui wafer.
<b>Fotolitografia</b>	Fasi di sviluppo e stripping che coinvolgono solventi organici aggressivi e rivelatori.	La costruzione resistente ai solventi garantisce assenza di gonfiore o ammorbidimento del materiale del supporto.
<b>Pulizia ad ultrasuoni</b>	Pulizia acustica ad alta frequenza di componenti elettronici delicati in soluzioni acquose.	Trasmette efficacemente l'energia ultrasonica proteggendo i componenti dagli urti meccanici.
<b>Lavorazione GaAs</b>	Incisione chimica umida e pulizia di substrati di semiconduttori composti per optoelettronica.	Supporto delicato e sicuro per substrati fragili durante le fasi di produzione critiche.

Parametro	Descrizione / Specifica (Serie PL-CP284)
<b>Codice articolo prodotto</b>	PL-CP284
<b>Materiale principale</b>	PTFE vergine (politetrafluoroetilene) ad alta purezza
<b>Compatibilità chimica</b>	Universale (Acidi forti, Basi, Solventi, Ossidanti)
<b>Dimensioni wafer standard</b>	Compatibile con wafer da 4 pollici, 6 pollici e 8 pollici
<b>Opzioni di personalizzazione</b>	Dimensioni, numero di slot e larghezza degli slot completamente personalizzabili
<b>Configurazioni maniglia</b>	Stili fisso, rimovibile o compatibile con robot (Personalizzabile)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio chiave
Parametro	Descrizione / Specifica (Serie PL-CP284)	
Temperatura di esercizio	-200°C a +260°C (Continuo)	
Finitura superficiale	Superficie a bassa porosità, lavorata CNC ad alta precisione	
Design slot	Profilo a V o personalizzato per area di contatto minima	
Processo di produzione	100% lavorato CNC per precisione e integrità strutturale	
Livello di purezza	Grado analisi in traccia, produzione senza metalli	